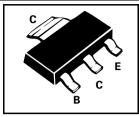
# SOT223 PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH PERFORMANCE TRANSISTOR

**ISSUE 2 - OCTOBER 1995** 

**FZT589** 

PARTMARKING DETAILS - FZT589 COMPLEMENTARY TYPES - FZT489



#### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V <sub>CBO</sub>	-50	V
Collector-Emitter Voltage	V <sub>CEO</sub>	-30	V
Emitter-Base Voltage	V <sub>EBO</sub>	-5	V
Peak Pulse Current	I <sub>CM</sub>	-2	А
Continuous Collector Current	I <sub>C</sub>	-1	Α
Base Current	I <sub>B</sub>	-200	mA
Power Dissipation at T <sub>amb</sub> =25°C	P <sub>tot</sub>	2	W
Operating and Storage Temperature Range	T <sub>j</sub> :T <sub>stg</sub>	-55 to +150	°C

# **ELECTRICAL CHARACTERISTICS** (at T<sub>amb</sub> = 25°C unless otherwise stated)

		al i iiv			
PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	V <sub>(BR)CBO</sub>	-50		V	I <sub>C</sub> =-100μA
Collector-Emitter Breakdown Voltage	V <sub>(BR)CEO</sub>	-30		٧	I <sub>C</sub> =-1mA*
Emitter-Base Breakdown Voltage	V <sub>(BR)EBO</sub>	-5		V	I <sub>E</sub> =-100μA
Collector Cut-Off Current	I <sub>CBO</sub>		-100	nA	V <sub>CB</sub> =-30V
Collector Emitter Cut-Off Current	I <sub>CES</sub>		-100	nA	V <sub>CES</sub> =-30V
Emitter Cut-Off Current	I <sub>EBO</sub>		-100	nA	V <sub>EB</sub> =-4V
Collector-Emitter Saturation Voltage	V <sub>CE(sat)</sub>		-0.35 -0.65	٧	I <sub>C</sub> =-1A, I <sub>B</sub> =-100mA* I <sub>C</sub> =-2A, I <sub>B</sub> =-200mA*
Base-Emitter Saturation Voltage	V <sub>BE(sat)</sub>		-1.2	٧	I <sub>C</sub> =-1A, I <sub>B</sub> =-100mA*
Base-Emitter Turn-On Voltage	V <sub>BE(on)</sub>		-1.1	٧	I <sub>C</sub> =-1A, V <sub>CE</sub> =-2V*
Static Forward Current Transfer Ratio	h <sub>FE</sub>	100 100 80 40	300		I <sub>C</sub> =-1mA, V <sub>CE</sub> =-2V* I <sub>C</sub> =-500mA, V <sub>CE</sub> =-2V* I <sub>C</sub> =-1A, V <sub>CE</sub> =-2V* I <sub>C</sub> =-2A, V <sub>CE</sub> =-2V*
Transition Frequency	f <sub>T</sub>	100		MHz	I <sub>C</sub> =-100mA, V <sub>CE</sub> =-5V f=100MHz
Output Capacitance	C <sub>obo</sub>		15	pF	V <sub>CB</sub> =-10V, f=1MHz

<sup>\*</sup>Measured under pulsed conditions. Pulse width=300µs. Duty cycle ≤2% For typical characteristics graphs see FMMT549 datasheet

# **ПОСТАВКА** ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001 Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

# Данный компонент на территории Российской Федерации Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

### http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

## Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г. Москва, ул. Щербаковская д. 3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru moschip.ru\_6 moschip.ru 4 moschip.ru 9